В.Н. АРУСТАМОВ, Х.Б. АШУРОВ, И.Х. ХУДАЙКУЛОВ, А.М ЖУРАВЛЕВ

*Институт ионно-плазменных и лазерных технологий, АН РУз,**Ташкент, Узбекистан.*

 **АНАЛИЗ НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОЧИЩЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАЗЦА В ОДНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ.**

Процесс отработки процесса очистки ионами плазмы тлеющего разряда проведена реализация комплексного процесса нанесение покрытия вакуумно-дуговым методом Процесс проводился при следующих параметрах ток вакуумного дугового разряда ток -80А-100А, напряжение на разрядном промежутке составляло 20 -24В, давление остаточной среды в камере составляло 10-1-10-3Па. Время осаждения покрытий варьировалось пределах 25- 30 мин

На рисунке 1 представлена вольт-амперная характеристика тлеющего разряда в процессе реализации очистки поверхности образцов из стали и латуни.

Рисунок 2-Зависимость тока и напряжения при очистке поверхности материала ионами плазмы тлеющего разряда.

 На основании полученных результатов получена зависимость тока от напряжения тлеющего разряда в процессе очистки ионами плазмы на электродах разрядной системы. Как видно из полученного графика при увеличении напряжения на электродах разрядной системы реализациии тлеющего разряда ток разряда увеличиваетя, что указывает на прямую зависимочсть интенсивности ионной бомбардировки и как следствие процесса очистки от напряжения на электродах.